

Development of nano-scale semiconductor chip separation equipment – EV Group plans to announce NanoCleave around the end of the year - October 31, 2023

Austrian semiconductor post-processing equipment company EVG is planning to launch a "NanoCleave" machine to separate (debond) ultra-thin semiconductor chips later this year. The new equipment uses an infrared (IR) laser to remove semiconductor chips as thin as 30 micrometers (µm) or less (nanometers (nm) from carrier-device wafers without damaging them. Debonding is realized by shooting an IR laser at the back of a silicon wafer. The inorganic release layer built by the vapor deposition process absorbs the IR light and precisely separates the silicon. While organic adhesives can be used to create micro-scale layers, inorganic adhesives can create thinner layers down to the nanoscale. "In order to stack semiconductor chips with hybrid bonding, the thickness between individual chips can only get thinner and thinner, and there is a challenge to maintain thermal stability when debonding," said Youngsik Yoon, country manager of EVG Korea. "This technology will help us realize thinner chips as the demand for high-level semiconductors such as high-bandwidth memory (HBM) increases." In Korea, Samsung Electronics and SK Hynix, which develop and produce HBM, are among the potential customers for EVG's NanoCleave equipment. In the semiconductor contract manufacturing (foundry) sector, the equipment can be utilized in the chiplet process, which integrates multiple chips on a single chip. "As we approach the point of commercialization of our NanoCleave equipment, we will try to conduct prototype tests with potential domestic customers," said Mr. Yoon. "EVG will strengthen its own equipment competitiveness and expand cooperation to help Korean semiconductor companies lead the development of future semiconductor processes, including next-generation semiconductors and chiplets for highperformance computing (HPC)."

나노 단위 반도체 칩 분리 장비 개발 이브이그룹, 나노클리브 연말 출시

브' 장비를 연말 출시한다.

신제품은 적외선(IR) 레이저를 활 이라고 말했다. 용해 30마이크로미터(4m) 이하 나노 상 없이 분리할 수 있는 장비다.

실리콘웨이퍼 뒷면에 IR 레이저를 쏘는 방식으로 디본딩을 구현한다. 증착 공정으로 구축한 무기 이형층이 IR 광을 흡수, 정밀하게 실리콘을 분 화 시점에 임박해 국내 잠재 고객사 리하는 기술이다. 유기 접착제를 사 용하면 마이크로 단위까지 층을 나눌 수 있지만 무기 접착제는 나노단위까 지보다 얇게 층을 나눌 수 있다.

윤영식 EVG 코리아 사장은 "반도 체 칩을 하이브리드 본딩으로 높이 쌓 으려면 개별 칩 간 두께는 점점 더 얇 아질 수 밖에 없고 디본딩할 때는 열

오스트리아 반도체 후공정 장비기 적 안정성을 유지해야 하는 숙제가 있 업 이브이그룹(EVG)이 초박형 반도 다"며 "고대역폭메모리(HBM) 등 고 체 칩을 분리(디본딩)하는 '나노클리 충 반도체 수요가 늘어나는 상황에서 얇은 두께의 칩 구현에 도움이 될 것*

국내에서는 HBM을 개발・생산하는 미터(mm) 단위 얇은 두께의 반도체 삼성전자와SK하이닉스가EVG나노클 칩을 캐리어·디바이스 웨이퍼에서 손 리브 장비 잠재 고객으로 분류된다. 반 도체 위탁생산(파운드리) 분야에서는 하나의 칩에 여러 개의 칩을 집적하는 칩렛 공정에서 장비를 활용할 수 있다.

> 윤 사장은 "나노클리브 장비 상용 대상 시제품 테스트를 진행할 예정* 이라며 "EVG는 자체 장비 경쟁력 강 화와함께 우리나라 반도체 기업이 고 성능 컴퓨팅(HPC) 분야 차세대 반 도체와 칩렛 등 미래 반도체 공정 발 전을 주도할 수 있도록 협력을 확대할 것"이라고 말했다.

> > 박종진기자 truth@etnews.com